








	<h2>SI7448DP-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI7448DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 20V 13.4A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SI7448DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 1038 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI7448DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 20V 13.4A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	1038 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	N-Channel 20V 13.4A (Ta) 1.9W (Ta) Surface Mount
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Verlustleistung (max)	1.9W (Ta)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	13.4A (Ta)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	6.5 mOhm @ 22A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	50nC @ 4.5V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Vgs (Max)	±12V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI7448DP-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SI7448DP-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI7448DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI7448DP-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI7447DP-T1-GE3 VB SI7447DP-T1-GE3 VB</p>	 <p>SI7448DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 13.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7450DP-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 200V 3.2A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7450DP-T1 VISHAY VISHAY QFN8</p>
 <p>SI7448DP-T1 VISHAY SI7448DP-T1 VISHAY</p>	 <p>SI7450DP SI SI7450DP SI</p>	 <p>SI7448DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 20V 13.4A PPAK SO-8</p>	 <p>SI7450 Vishay Precision Group SI7450 VISHAY</p>

heiße Teile

Mehr

SI7444DP-T1-GE3	SI7445DP-T1	SI7445DP-T1-E3	SI7445DP-T1-E3	SI7445DP-T1-GE3
SI7445DP-T1-GE3	SI7446BDP	SI7446BDP-T1-E3	SI7446BDP-T1-E3	SI7446BDP-T1-GE3
SI7446BDP-T1-GE3	SI7446BDP-T1-T3	SI7446DP	SI7446DP-T1	SI7446DP-T1-GE3
SI7446DP-T1	SI7447ADP	SI7447ADP-T1-E3	SI7447ADP-T1-E3	SI7447ADP-T1-GE3
SI7447ADP-T1-GE3	SI7447DP-T1-GE3	SI7448DP	SI7448DP-T1-E3	SI7448DP-T1-E3
SI7448DP-T1-GE3	SI7450DP	SI7450DP-T1-E3	SI7450DP-T1-E3	SI7450DP-T1-GE3
SI7450DP-T1-GE3	SI7452DP-T1-E3	SI7452DP-T1-E3	SI7452DP-T1-GE3	SI7452DP-T1-GE3
SI7454CDP-T1-GE3	SI7454CDP-T1-GE3	SI7454DDP-T1-GE3	SI7454DDP-T1-GE3	SI7454DP
SI7454DP-T1-E3	SI7454DP-T1-E3	SI7454DP-T1-GE3	SI7454DP-T1-GE3	SI7456CDP-T1-GE3
SI7456CDP-T1-GE3	SI7456DDP-T1-GE3	SI7456DDP-T1-GE3	SI7456DP	SI7456DP-T1-E3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited